

SILICON CONTROLLED RECTIFIER
Qualified per MIL-PRF-19500/276
Devices

2N2323	2N2324	2N2326	2N2328		
2N2323S	2N2324S	2N2326S	2N2328S	2N2329	
2N2323A	2N2324A	2N2326A	2N2328A	2N2329S	
2N2323AS	2N2324AS	2N2326AS	2N2328AS		

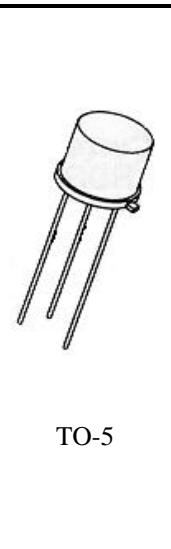
Qualified Level

 JAN
 JANTX
 JANTXV

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Sym	2N2323,S/ 2N2323A,S	2N2324,S/ 2N2324A,S	2N2326,S/ 2N2326A,S	2N2328,S/ 2N2328A,S	2N2329,S	Unit
Reverse Voltage	V _{RM}	50	100	200	300	400	Vdc
Working Peak Reverse Voltage	V _{RM}	75	150	300	400	500	Vpk
Forward Blocking Voltage	V _{FBXM}	50 ^(3/4)	100 ^(3/4)	200 ^(3/4)	300 ^(3/4)	400 ⁽³⁾	Vpk
Average Forward Current ⁽¹⁾	I _O			0.22			Adc
Forward Current Surge Peak ⁽²⁾	I _{FSM}			15			Adc
Cathode-Gate Current	V _{KGM}			6			Vpk
Operating Temperature	T _{op}			-65 to +125			°C
Storage Junction Temp	T _{stg}			-65 to +150			°C

- 1) This average forward current is for an ambient temperature of 80°C and 180 electrical degrees of conduction.
- 2) Surge current is non-recurrent. The rate of rise of peak surge current shall not exceed 40 A during the first 5 µs after switching from the ‘off’ (blocking) to the ‘on’ (conducting) state. This is measured from the point where the thyristor voltage has decayed to 90% of its initial blocking value.
- 3) Gate connected to cathode through 1,000 ohm resistor.
- 4) Gate connected to cathode through 2,000 ohm resistor.


 *See appendix A
 for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
SUBGROUP 2 TESTING				
Reverse Blocking Current				
R ₂ = 1 kµ	2N2323 thru 2N2329 2N2323S thru 2N2329S			
R ₂ = 2 kµ	2N2323A thru 2N2328A 2N2323AS thru 2N2328AS			
V _R = 50 Vdc	2N2323, S, A, AS			
V _R = 100 Vdc	2N2324, S, A, AS			
V _R = 200 Vdc	2N2326, S, A, AS			
V _R = 300 Vdc	2N2328, S, A, AS			
V _R = 400 Vdc	2N2329, S,			

2N2323, A, AS, S; 2N2324, A, AS, S; 2N2326, A, AS, S; 2N2328, A, AS, S; 2N232, S JAN SERIES
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
Forward Blocking Current $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ 2N2323 thru 2N2329 2N2323S thru 2N2329S				
$R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ 2N2323A thru 2N2328A 2N2323AS thru 2N2328AS				
$V_R = 50 \text{ Vdc}$ $V_R = 100 \text{ Vdc}$ $V_R = 200 \text{ Vdc}$ $V_R = 300 \text{ Vdc}$ $V_R = 400 \text{ Vdc}$ 2N2323, S, A, AS 2N2324, S, A, AS 2N2326, S, A, AS 2N2328, S, A, AS 2N2329, S	I_{FBX1}		10	μAdc
Reverse Gate Current $V_{KG} = 6 \text{ Vdc}$	I_{KG}		200	μAdc
Gate Trigger Voltage and Current $V_2 = V_{FBX} = 6 \text{ Vdc}$; $R_L = 100 \Omega$ $R_e = 1 \text{ k}\Omega$ 2N2323 thru 2N2329 and 2N2323S thru 2N2329S	V_{GT1}	0.35	0.80	Vdc
$R_e = 2 \text{ k}\Omega$ 2N2323A thru 2N2328A and 2N2323AS thru 2N2328AS	I_{GT1}	0.35	0.60	μAdc
			20	Vdc
				μAdc

SUBGROUP 4 TESTING

Exponential Rate of Voltage Rise $T_A = 125^{\circ}\text{C}$ $50 \Omega \leq R_L \leq 400 \Omega$, $C = 0.1$ to $1.0 \mu\text{F}$, repetition rate = 60 pps, test duration = 15 seconds $dv/dt = 1.8 \text{ v}/\mu\text{s}$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ 2N2323 thru 2N2329 and 2N2323S thru 2N2329S				
$dv/dt = 0.7 \text{ v}/\mu\text{s}$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ 2N2323A thru 2N2328A and 2N2323AS thru 2N2328AS	V_{FBX}			Vdc
$V_{AA} = 50 \text{ Vdc}$ $V_{AA} = 100 \text{ Vdc}$ $V_{AA} = 200 \text{ Vdc}$ $V_{AA} = 300 \text{ Vdc}$ $V_{AA} = 400 \text{ Vdc}$ 2N2323, S, A, AS 2N2324, S, A, AS 2N2326, S, A, AS 2N2328, S, A, AS 2N2329, S		47 95 190 285 380		
Forward "on" Voltage $i_{FM} = 4\text{a (pk)}$ (pulse), pulse width = 8.5 ms, max; duty cycle = 2% max	V_{FM}		2.2	V(pk)
Holding Current $V_{AA} = 24 \text{ Vdc}$ max, $I_{F1} = 100 \text{ mAdc}$, $I_{F2} = 10 \text{ mAdc}$ Gate trigger source voltage = 6 Vdc, trigger pulse width = 25 μs min., $R_2 = 330 \Omega$ $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ 2N2323 thru 2N2329 and 2N2323S thru 2N2329S				
$R_3 = 2 \text{ k}\Omega$ 2N2323A thru 2N2328A and 2N2323AS thru 2N2328AS	I_{HOX}		2.0	mAdc



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.